

УДК 548.0 : 535.37

СУЖЕНИЕ ЛИНИЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ И ОПТИЧЕСКОЕ ДЕТЕКТИРОВАНИЕ

НЕРАВНОВЕСНЫХ ТЕРАГЕРЦОВЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ФОНОНОВ
В РАЗУПОРЯДОЧЕННЫХ КРИСТАЛЛАХ $MgAl_2O_4 : Cr^{3+}$

*C. A. Басун, П. Дерень¹, А. А. Каплянский, В. Стреньк,¹
С. П. Феофилов*

Методом селективного лазерного возбуждения внутри неоднородно-уширенного контура спектральной линии исследована структура возбужденного 2E состояния ионов Cr^{3+} в разупорядоченном кристалле $MgAl_2O_4 : Cr^{3+}$. Осуществлено спектрально-селективное оптическое детектирование неравновесных акустических фононов в области частот $5 - 100 \text{ cm}^{-1}$ путем наблюдения антистоксовой люминесценции ионов Cr^{3+} . Полученные результаты указывают на диффузный режим распространения фононов таких частот и на существенную роль ангармонических процессов фононного взаимодействия в кристалле.

В последнее время значительное внимание уделяется исследованиям свойств примесных ионов Cr^{3+} в стеклах [1, 2] и разупорядоченных кристаллах [3, 4], в которых ионы Cr^{3+} находятся в окружении искаженного кислородного октаэдра. Известный электронный переход в метастабильное состояние иона Cr^{3+} $^4A_2 - ^2E$ (R -линия) в таких системах обладает сильным неоднородным уширением, и в исследованиях обычно используется метод сужения линий флуоресценции при резонансном лазерном возбуждении ионов внутри неоднородно-уширенного контура линии. В настоящей работе этот метод впервые применен к исследованию Cr^{3+} в разупорядоченных кристаллах синтетической магниево-алюминиевой шпинели $MgAl_2O_4 : Cr^{3+}$. На основе результатов исследования реализован новый вариант методики «фононного спектрометра» [5] для оптического детектирования с частотным и временным разрешением неравновесных терагерцовых акустических фононов в широком частотном диапазоне в твердых телах.

Исследовались кристаллы $MgAl_2O_4 : Cr^{3+}$ (концентрация хрома ≈ 0.1 ат. %), выращенные методом Вернейля. В отличие от упорядоченных натуральных кристаллов шпинели [6] исследованные синтетические кристаллы обладают сильным разупорядочением, обусловленным перераспределением Mg и Al по позициям идеальной структуры (в которой ионы Mg занимают «тетраэдрическую», а Al — «октаэдрическую» позицию [7-9]). О сильном разупорядочении прямо свидетельствует весьма большая величина неоднородного уширения линий флуоресценции ионов Cr^{3+} , занимающих октаэдрические позиции [7, 8, 10]. Если в натуральной шпинели неоднородное уширение R -линии $^2E - ^4A_2$ в спектрах Cr^{3+} составляет $\approx 5 \text{ cm}^{-1}$ [6], то в исследованных образцах ширина R -линий не меньше $\approx 150 \text{ cm}^{-1}$.

На рис. 1, а приведены спектры люминесценции кристаллов шпинели [11, 12] при «нерезонансном» возбуждении Cr^{3+} через U -полосу ($^4A_2 \rightarrow ^4T_2$)

¹ Институт низких температур и структурных исследований ПАН. Вроцлав, ПНР.

и Y -полосу (${}^4A_2 \rightarrow {}^4T_1$) линиями Ar лазера $\lambda_{\text{возб}} = 514.5$ и 457.9 нм соответственно. Существенное различие двух спектров обусловлено, очевидно, чрезвычайно сильным неоднородным уширением спектров Cr^{3+} , при котором даже в области широких полос U , Y при разных $\lambda_{\text{возб}}$ возбуждаются различные группы Cr^{3+} центров.

Для изучения структуры возбужденного 2E -состояния ионов Cr^{3+} были осуществлены опыты по селективному «резонансному» возбуждению R -люминесценции (${}^2E \rightarrow {}^4A_2$) в области $680-710$ нм при помощи лазера на красителе, причем ширина возбуждающей линии $\nu_{\text{возб}}$ составляла ~ 1 см $^{-1}$. (Лазер на красителе накачивался импульсным лазером на патронах меди с $f_{\text{в.з.}} = 10$ кГц, $\Delta t = 20$ нс). На рис. 1, б представлены спектры R -люминесценции при селективном лазерном возбуждении при $T = 77$ (1), 1.8 К (2). Видно, что при $T = 77$ К в спектре люминесценции вблизи возбуждающей линии $\nu_{\text{возб}}$ в области $\nu_{\text{возб}} \pm 130$ см $^{-1}$ наблюдается отчетливо выраженная структура, зависящая от значения $\nu_{\text{возб}}$. При $T = 1.8$ К антистоксовая часть спектра люминесценции ($\nu > \nu_{\text{возб}}$) полностью вымощена. Время затухания люминесценции, измеренное при прерывистом возбуждении ($T = 77$ К), составляло в зависимости от $\nu_{\text{возб}}$ и регистрируемой длины волны излучения $\tau \sim 1-10$ мс.

Наблюдаемые спектры люминесценции естественно интерпретировать

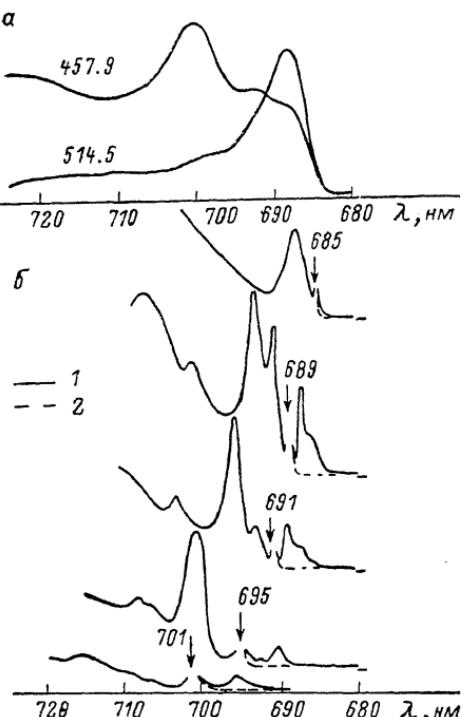


Рис. 1. Спектры люминесценции $\text{MgAl}_2\text{O}_4 : \text{Cr}^{3+}$ при возбуждении линиями аргонового лазера через U - и Y -полосы поглощения (а) и при селективном лазерном возбуждении линиями $\lambda_{\text{возб}}$ (указаны) внутри неоднородно-упрежденного R -контура (б).

как ${}^2E \rightarrow {}^4A_2$ излучение ионов Cr^{3+} в разупорядоченной матрице шпинели. Следует ожидать, что в ионах Cr^{3+} , находящихся внутри искаженных кислородных октаэдров и подверженных действию кристаллических полей, меняющихся от позиции к позиции вследствие разупорядоченности матрицы, имеют место в общем случае неодинаковые по величине дублетные расщепления орбитально-вырожденного 2E -уровня и сдвиги центра тяжести дублета. По аналогии с номенклатурой для рубина $\text{Al}_2\text{O}_3 : \text{Cr}^{3+}$ обозначим условно энергетически нижние компоненты этих дублетов как \bar{E} (2E), а верхние — как $2\bar{A}$ (2E). Благодаря сильному разбросу кристаллических полей сдвиги \bar{E} и $2\bar{A}$ уровней превышают расстояния Δ между ними и в общем неоднородном распределении ансамбля Cr^{3+} уровни \bar{E} и $2\bar{A}$ перекрыты друг с другом. Поэтому при селективном лазерном возбуждении частотой $\nu_{\text{возб}}$ внутри неоднородного контура ${}^4A_2 - {}^2E$ переходов возбуждаются как \bar{E} , так и $2\bar{A}$ -состояния различных ионов (рис. 2). Излучение же в каждой группе возбужденных ионов идет из обоих состояний \bar{E} , $2\bar{A}$, заселение которых определяется температурой. В итоге в спектре наблюдаются: 1) резонансные с $\nu_{\text{возб}}$ переходы ($2\bar{A} \rightarrow {}^4A_2$ в ионах, возбуждаемых через $2\bar{A}$, и $\bar{E} \rightarrow {}^4A_2$ в ионах, возбуждаемых через \bar{E}); 2) нерезонансные переходы $2\bar{A} \rightarrow {}^4A_2$ в ионах, возбуждаемых через \bar{E} (антистокс) и $\bar{E} \rightarrow {}^4A_2$ в ионах, возбуждаемых через $2\bar{A}$ (стокс). Нерезонансные ${}^2E \rightarrow {}^4A_2$ переходы в ионах Cr^{3+} с различной величиной $2\bar{A} - \bar{E}$ расщепления Δ и формируют наблюданную в широком спектраль-

ном интервале структуру вблизи $\nu_{\text{возб}}$ (рис. 2). Эта структура отражает распределение ионов $P(\Delta)$ (в антистоксовой части надо учесть температурный множитель $e^{-\Delta/kT}$); при некоторых $\nu_{\text{возб}}$ распределение $P(\Delta)$ в отличие от результатов работ [1-4] имеет двугорбый вид (рис. 1).

В более длинноволновой спектральной области $\lambda \approx 700-720$ нм наблюдается сплошной структурированный спектр люминесценции со временем затухания порядка миллисекунд. Этот спектр является наложением стоксовых вибронных крыльев резонансно возбуждаемых бесфононных R -линий излучения и бесфононных R -переходов, возбуждаемых через их коротковолновые вибронные крылья в поглощении.

При низкой температуре $T=1.8$ К вся люминесценция Cr^{3+} обусловлена переходами из нижних E -состояний 2E -дублетов. Антистоксова $2\bar{A} \rightarrow {}^4A_2$ люминесценция в области $\nu > \nu_{\text{возб}}$ не наблюдается из-за ма-

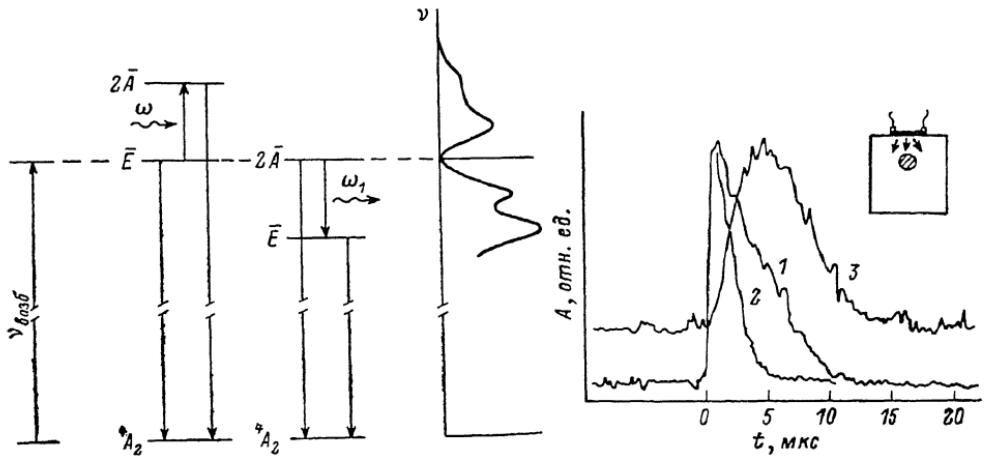


Рис. 2. Схема селективного возбуждения 2E -флуоресценции ионов Cr^{3+} внутри неоднородно-уширенного контура.

Рис. 3. Импульсы антистоксовой флуоресценции на частоте $\nu_{\text{возб}} + \omega$, индуцированные тепловыми импульсами. $\lambda_{\text{возб}} = 688.5$ нм.

ω (см^{-1}), l (мм): 1 — 20, 0; 2 — 60, 0; 3 — 20, 15. l — расстояние от нагревателя до детектирующего возбужденного объема.

лости чисел заполнения фононов соответствующих частот. Если в этих условиях в возбужденный объем кристалла инжектировать импульсы неравновесных фононов, то фононы частоты ω будут индуцировать резонансные однофононные переходы $\bar{E} \rightarrow 2\bar{A}$ у ионов с $\Delta = \hbar\omega$, что приведет к возгоранию импульсов антистоксовой $2\bar{A} \rightarrow {}^4A_2$ люминесценции в области частот $\nu > \nu_{\text{возб}}$. При этом интенсивность и кинетика люминесценции на частоте $\nu_{\text{возб}} + \omega$ будут отражать эволюцию во времени плотности фононов частоты ω в возбужденном объеме. Таким образом, в кристалле $\text{MgAl}_2\text{O}_4 : \text{Cr}^{3+}$ может быть реализовано оптическое детектирование с временным разрешением высокочастотных акустических фононов, аналогичное детектированию фононов 29 см^{-1} в рубине [18]. Однако в отличие от рубина наблюдение импульсов антистоксовой люминесценции позволяет в принципе детектировать неравновесные фононы различных частот в широком интервале терагерцевого диапазона («фононный спектрометр»).²

В качестве примера укажем на опыты по флуоресцентному детектированию фононов в диапазоне $5-100 \text{ см}^{-1}$, инжектированных в кристалл

² Недавно [14] сужение R-линий флуоресценции в рубине использовано для частотно-селективного детектирования с временным разрешением фононов в чрезвычайно узкой ($\sim 10^{-2} \text{ см}^{-1}$) полосе частот вблизи резонансной частоты 29 см^{-1} , отвечающей переходу $\bar{E}({}^2E) - 2\bar{A}({}^2E)$.

Легко видеть, что частотно-селективное детектирование реализуется и в случае более сложной системы возбужденных уровней, характерной для пар ионов хрома, которые могут давать вклад в спектр шипинelli.

по методу тепловых импульсов [15]. Тепловые импульсы впрыскивались в кристалл $MgAl_2O_4 : Cr^{3+}$, погруженный в откачиваемый жидкий гелий ($T=1.8$ К) путем импульсного нагрева ($\Delta t=0.2$ мкс) тонкой константановой пленки на поверхности образца (рис. 3, вставка). Установлено, что форма импульсов люминесценции не зависит от $v_{возб}$, а зависит только от частотного расстояния ω от $v_{возб}$, на котором производится измерение импульсов. На рис. 3 показаны импульсы антистоксовой R -люминесценции на частотах $v_{возб}+20$, $v_{возб}+60$ см $^{-1}$, измеренные вблизи нагревателя, и импульс на частоте $v_{возб}+20$ см $^{-1}$, измеренный на расстоянии $l=1.5$ мм от нагревателя. Большая ширина (~10 мкс) импульсов и характер изменения формы импульсов ($\omega=20$ см $^{-1}$) с ростом l показывают, что в разупорядоченной шинели режим распространения высокочастотных фононов является диффузионным и фононы, распространяющиеся от нагревателя до детектирующего возбужденного объема, испытывают многократное рассеяние. Сильное уменьшение ширины импульса с ростом частоты ω от 20 до 60 см $^{-1}$ (при $l=0$) также характерно для диффузионного распространения фононов [16]; оно обусловлено, в частности, сильным уменьшением времени τ_a ангармонического распада фононов с ростом частоты ($\tau_a^{-1} \sim \omega^5$). Использование методики «фононного спектрометра» в рассмотренном варианте представляется перспективным для изучения динамического поведения терагерцевых фононов в разупорядоченных кристаллах, а также в стеклах.

Л и т е р а т у р а

- [1] Bergin F. J., Donegan J. F., Glynn T. J., Imbush G. F. // J. Lumin. 1986. V. 34. N 6. P. 307—321.
- [2] Wojtowicz A. J., Lempicki A. // J. Lumin. 1988. V. 39. N 4. P. 189—203.
- [3] Morgan G. P., Bergin F. J., Glynn T. J., Imbush G. F. // J. Lumin. 1987. V. 38. N 1—6. P. 195—197.
- [4] Montteil A., Garapon C., Boulon G. // J. Lumin. 1988. V. 39. N 3. P. 167—173.
- [5] Bron W. E. // Nonequilibrium phonons in nonmetallic crystals (Modern problems in condensed matter sciences. V. 16) / Ed. by W. Eisenmenger and A. A. Kaplyanskii. North-Holland, 1986. P. 227—275.
- [6] Wood D. L., Imbush G. F., Macfarlane R. M. et al. // J. Chem. Phys. 1968. V. 48. N 11. P. 5255—5263.
- [7] Mikenda W., Preisinger A. // J. Lumin. 1981. V. 26. P. 53—66.
- [8] Mikenda W., Preisinger A. // J. Lumin. 1981. V. 26. P. 67—83.
- [9] Mikenda W. // J. Lumin. 1981. V. 26. P. 85—98.
- [10] Пастернак Л. Б., Ремигайло Ю. Л., Севастьянов Б. К. // ЖПС. 1976. Т. 25. № 1. С. 110—117.
- [11] Strek W., Dereń P., Jeżowska-Trzebiatowska B. // J. de Phys. 1987. V. 48. Suppl. N 12. P. C7—475—C7—477.
- [12] Strek W., Dereń P., Jeżowska-Trzebiatowska B. // J. Lumin. 1988. V. 40—41. P. 421—422.
- [13] Renk K. F., Deisenhofer J. // Phys. Rev. Lett. 1971. V. 26. N 13. P. 764—766.
- [14] van Dort M. J., Dijkhuis J. I., de Wijn H. W. // J. Lumin. 1987. V. 38. N 1—6. P. 217—220.
- [15] Гутфельд Р. // Физическая акустика / Под ред. У. Мэзона. М., 1973. Т. 5. С. 267—329.
- [16] Bron W. E., Grill W. // Phys. Rev. B. 1977. V. 16. N 12. P. 5303—5320.

Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе АН СССР
Ленинград

Поступило в Редакцию
5 октября 1988 г.